

证券代码：301418

证券简称：协昌科技

公告编码：2023-061

## 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家知识产权局授予的两项发明专利证书，专利证书具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利类型	专利权人	证书号
1	一种低功耗屏蔽栅型半导体功率器件及其制备方法	ZL 2019 1 0376360.4	2019年05月07日	2023年12月19日	发明专利	张家港凯思半导体有限公司，江苏协昌电子科技股份有限公司，张家港凯诚软件科技有限公司	第6569557号
2	一种低栅极内阻屏蔽栅沟槽MOSFET	ZL 2023 1 0916422.2	2023年07月25日	2023年12月19日	发明专利	张家港凯思半导体有限公司	第6569525号

注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

（一）发明专利“一种低功耗屏蔽栅型半导体功率器件及其制备方法”涉及到一种半导体功率器件，尤其是一种具有低功耗屏蔽栅型半导体功率器件及其制备方法。本发明所解决的技术问题是：提供一种低功耗屏蔽栅型半导体功率器件，避免了栅氧层在多晶硅上的生长步骤，提高了栅极氧化层的可靠性。且引入沟槽底部的浮置阱结构，提高了器件的耐压能力。

（二）发明专利“一种低栅极内阻屏蔽栅沟槽MOSFET”涉及到一种屏蔽栅沟槽MOSFET，尤其涉及到一种低栅极内阻屏蔽栅沟槽MOSFET。本发明所解决的技术问题是：提供一种通过对其沟槽中内部结构的改进来降低栅极内阻的低栅极内阻屏蔽栅沟槽MOSFET。

上述两项发明专利为公司自主研发。上述专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。

特此公告。

江苏协昌电子科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日